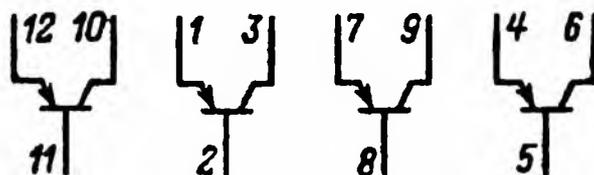


КР198НТ7А, КР198НТ7Б

Микросхемы представляют собой матрицу из *p-n-p* транзисторов. Содержат 4 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1 масса не более 1 г.



Электрическая схема КР198НТ7

Назначение выводов: 1 — эмиттер *VT2*; 2 — база *VT2*; 3 — коллектор *VT2*; 4 — эмиттер *VT4*; 5 — база *VT4*; 6 — коллектор *VT5*; 7 — эмиттер *VT3*; 8 — база *VT3*; 9 — коллектор *VT3*; 10 — коллектор *VT1*, 11 — база *VT1*; 12 — эмиттер *VT1*; 13, 14 — свободные.

Электрические параметры

Напряжение насыщения база — эмиттер	≤ 1 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер	...	≤ 1В
Обратный ток коллектора	≤ 0,3 мкА
Статический коэффициент передачи тока:		
КР198НТ7А	20...125
КР198НТ7Б	60...300

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор — база	20 В
Напряжение эмиттер — база	5 В
Ток коллектора	10 мА
Рассеиваемая мощность одним транзистором	...	20 мВт
Температура окружающей среды	-45...+85 °С